



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20130218002

2013 年 2 月 26 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

PWR TPS51206DSQ 製品 前処理サイト追加のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただいたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab	☒ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐ -	
変更内容	PWR TPS51206DSQ 製品 前処理サイト追加 現行 : TI-MIH08(日本) 変更後 : TI-MIH08(日本), TI-FFAB(ドイツ)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	6月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了		
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容：弊社 PWR(パワーマネジメント) LBC7プロセス TPS51206DSQ製品の前処理サイトについて、現行 TI-MIH08(日本)サイトにおいて製造していますが、供給能力確保の為に、これに加えて、TI-FFAB(ドイツ)サイトを追加します。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
LBC7プロセス前処理サイト	TI-MIH08(日本)	TI-MIH08(日本) TI-FFAB(ドイツ)
ウェーハ径	200 mm	200mm

理由：供給能力確保の為

詳細：

TI-FFABサイトにおけるLBC7プロセスによる製造は認定されています。下記信頼性試験結果(2007年11月27日終了)を参照ください。

対象製品リスト

対象製品名	
TPS51206DSQR	TPS51206DSQT

製品表示

この変更に伴い、出荷ラベルに記載の前処理サイト・生産国記号(ラベルの"20L/21L"の箇所)及びラベル上の表示位置は下記のようになります。

	現行	追加認定
Fab Site: 前処理サイト	TI-MIH08	TI-FFAB
CSO (20L): 前処理サイト記号	MH8	TID
CCO (21L): 生産国記号	JPN	DEU



図1 出荷ラベルの例

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2007年11月27日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	TCA6416PW	-	-	
Wafer Fab Site:	FFAB	Wafer Fab Process:	LBC7	
Wafer Diameter(mm):	200	Metallization:	TiN/AICu.5%/TiN	
Passivation:	10KACN	MSL:	JEDEC L-1/260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Steady-state Life Test	150C, 300 Hrs	116/0	116/0	116/0
Electrical Characterization	per datasheet specification	Approved	Approved	Approved
**High Temp Storage Bake	150C, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cyc	77/0	77/0	77/0
ESD HBM	1000V	3/0	3/0	3/0
ESD CDM	250V	3/0	3/0	3/0
Latch-up	per JESD78	6/0	6/0	6/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
X-ray	top side only	5/0	5/0	5/0
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C.				